

2014 年合肥工业大学②半导体器件物理考研复试试题(回忆版)

本试题由 kaoyan.com 网友 xt2010569 提供

- 1、特征频率，MOS 管饱和区漏极电流不饱和原因，扩散电容与势垒电容的区别
- 2、两种 MOSFET 的小尺寸效应及对各种器件的影响
- 3、推导 Sah 方程，验证饱和区 g_m 和线性区 g_d 的关系
- 4、在 NPN 型双极型晶体管正向有源区工作时 $I_c = qAE$ 等等，不好打 $\exp(qV_{be}/kT)$ 求 β_F 和提高 β_F 的措施
- 5、给出理想 N 型半导体 MOS 电容的 C-V 特性曲线，并分区进行分析。

以上试题来自 kaoyan.com 网友的回忆，仅供参考，纠错请发邮件至 suggest@kaoyan.com。